

パワー半導体の新技術・新製品の開発を加速し、低炭素社会実現に貢献
パワーデバイス製作所「開発試作棟」建設のお知らせ

三菱電機株式会社は、パワー半導体の開発・製造を行うパワーデバイス製作所（福岡県福岡市）に、新たに「開発試作棟」を建設します。低炭素社会実現に貢献するキーデバイスとして、需要が拡大しているパワー半導体の開発体制を強化し、さらなる電力損失低減のための新技術・新製品の開発を加速します。投資金額は約45億円で、稼働開始は2022年9月を予定しています。



パワーデバイス製作所開発試作棟 完成予想図

開発試作棟の概要

所在地	福岡市西区今宿東一丁目1番1号（パワーデバイス製作所内）
建築面積	約1,640㎡（延床面積 約10,350㎡）
構造	鉄骨(S)造、地上6階建
主な設備	開発実験室、開発品試作ライン、性能試験室
環境・省エネ対策	・高効率機器導入(空調機・換気設備・変圧器) ・人感センサ、照度センサ付きLED照明設置 ・建物内装への木質材料使用
竣工予定	2022年8月
稼働開始予定	2022年9月
投資総額	約45億円

背景と狙い

近年、低炭素社会実現に貢献するキーデバイスとして、電力を効率よく制御するパワー半導体の需要が拡大・多様化しています。

当社はこれまで、産業用途や自動車用途などの省エネ性に優れた多くのパワー半導体を開発・製造してきました。今回、開発・製造拠点であるパワーデバイス製作所に新たに「開発試作棟」を建設し、敷地内に分散していた開発実験室、開発品試作ライン、性能試験室、分析評価機能を1カ所に集結させることで、新技術・新製品の開発を加速します。また、新製品をより早くお客様へ提供することで、「持続可能性」と「安心・安全・快適性」が両立する豊かな社会の実現に貢献します。

お客様からのお問い合わせ先

三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所
〒819-0192 福岡県福岡市西区今宿東一丁目1番1号
TEL 092-805-3012 FAX 092-805-3731